

24.685
Роз 1

С д е л а н о в С С С Р

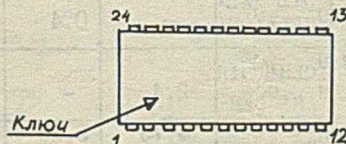
Э Т И К Е Т К А

МИКРОСХЕМА ТИПА К573РФ2

Постоянное запоминающее устройство с ультрафиолетовым стиранием и электрической записью информации, с длительным сроком хранения информации при включенном или отключенном напряжении питания.

Число информационных слов - 2048, число разрядов в информационном слове - 8.

Схема расположения выводов



Обозначение выводов показано условно.

Форма ключа не регламентируется.

Масса не более 5 г.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРИ НОРМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Напряжение низкого уровня сигнала
выходной информации, V

не более 0,4

Напряжение высокого уровня сигнала
выходной информации, V

не менее 2,4

Время хранения информации при включенном
напряжении питания, h

не менее 25000

Время хранения информации при отключенном
напряжении питания, h

не менее 100000

Время выборки адреса, μ s

не более 0,45

Количество циклов перепрограммирования,
цикл

не менее 100

[1040dm]
31.10.12
12.12.12

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование параметра, режим, единица измерения	Буквен- ное обозна- чение	Н о р м а			
		предельно до- пустимый режим		предельный режим	
		не менее	не более	не менее	не более
Напряжение низкого уровня входных сигналов, V	$U_{DIL}, U_{AL},$ U_{CEL}, U_{OEL}	-	0,4	-0,3	0,8
Напряжение высокого уровня входных сигналов, U	U_{OEH}, U_{DIE} U_{AH}, U_{CEH}	2,4	-	2,0	6,0
Напряжение питания, U	U_{CC}	4,75	5,25	-0,3	6,0
Напряжение сигнала записи высокого уровня, U	U_{WRH}	23,5	25,5	-0,3	26,0
Напряжение сигнала записи низкого уровня, U	U_{WRL}	4,75	5,25	-0,3	6,0
Температура хранения микросхем, K	T	228	349	213	398

- Примечания: 1. Значения напряжения даны относительно вывода I2.
2. После хранения микросхем при предельной температуре 398K информацию необходимо стереть и записать вновь.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функциональное состояние микросхем	Функциональное назначение и номер вывода				
	"Вход адресный" (8-1, 19, 22, 23)	"Вход сигнала разрешения обращения" (18)	"Вход сигнала для разрешения выхода" (20)	"Вход сигнала записи-считывания" (21)	"Выход-вход" (9-11, 13-17)
Считывание информации	U_{A1}, U_{AH}	U_{CEL}	U_{CEL}	U_{WRL}	U_{DOL} при $I_{OH} \geq 2,1 \text{ мА}$ U_{DON} при $I_{OH} < 0,4 \text{ мА}$
Выбор микросхем	Произвольно	U_{CEL}	U_{OEL}	U_{WRL}	Состояние "Выключено"
Снижение потребляемой мощности	Произвольно	U_{CEL}	Произвольно	U_{WRL}	Состояние "Выключено"
Программирование (запись)	U_{A1}, U_{AH}	Импульс U_{CEN}	U_{OEN}	U_{WRH}	U_{DIL}, U_{DIN}
Контроль после программирования	U_{A1}, U_{AH}	U_{CEL}	U_{OEL}	U_{WRH}	U_{DOL} при $I_{OH} \geq 2,1 \text{ мА}$ U_{DON} при $I_{OH} < 0,4 \text{ мА}$
Защит программирования (записи)	Произвольно	U_{CEL}	U_{OEN}	U_{WRH}	Состояние "Выключено"
Странне информации	Облучение кристалла микросхемы УФ-излучением $\lambda \leq 400 \text{ нм}$ имущественного излучения на $\lambda = 253,7 \text{ нм}$. Температура корпуса не более 343 К.				пре-этом

Примечание: $U_{A1} = U_{CEL} = U_{OEL} = (0-0,4) \text{ В}$; $U_{AH} = U_{CEN} = U_{OEN} = (2,4-5,25) \text{ В}$; $U_{CC} = U_{WRL} = 5 \text{ В} \pm 5\%$; $U_{WRH} = (23,5-25,5) \text{ В}$.

Вывод 24 - U_{CC} .